

## 射頻振盪器之製作

### 壹、實驗目的

- 一、了解振盪器之基本原理。
- 二、設計和製作振盪器。

### 貳、實驗原理

振盪器在通訊系統中扮演了重要的角色，無論是載波或者是本地振盪信號等，皆由振盪器產生。振盪器的特性就是不用輸入信號，而在輸出端便有信號輸出。

## ■ 1-2 通訊原理實習

圖 1-1 為振盪電路的基本方塊圖，其中包含一個放大器及一個由諧振電路(resonator)所構成的回授網路。當電源開啓時，在電路中會產生雜訊，但是雜訊經由放大器放大後，再經過具有濾波功能的諧振電路，最後將只留下諧振電路通帶區內的頻率成份，而其他頻率成份皆會被濾除；而通過諧振電路的信號再送入放大器的輸入端，若所得的信號與原有的信號相位相同則再將其放大。

振盪器是否會振盪，我們必須考慮以下兩點，其分別為環路增益至少為 1 和相位偏移為零(即正回授)，此為振盪準則。即

$$A \beta(S) \geq 1 \quad (1-1)$$

其中

$A$ ：放大器之增益

$\beta(S)$ ：回授因數

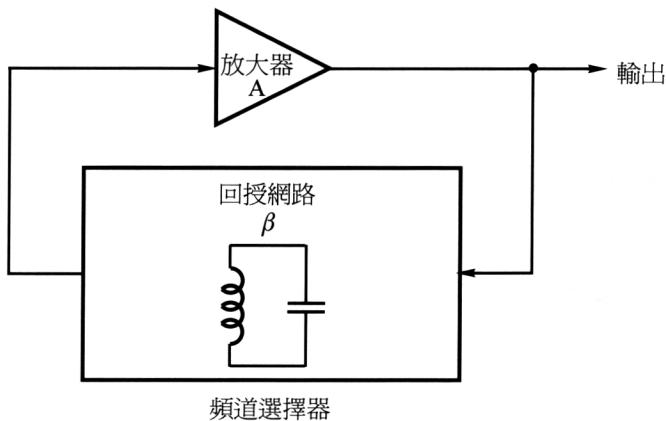


圖 1-1 振盪電路基本方塊圖

在本實驗中使用電晶體放大器，利用電晶體的  $i_c - v_{be}$  之非線性特性，可以當成振幅限制器，所以當工作穩定時環路增益為 1，此稱為自我限制振盪器(Self-Limiting Oscillator)，所以在電路中不用加其它振幅限制電路

## 一、考畢子振盪器(Colpitts Oscillator)

圖1-2為考畢子振盪器交流等效電路，其中並聯的LC諧振電路連接在電晶體放大器的基極和集極之間，部份的電壓經由 $C_1$ 和 $C_2$ 所組成的分壓器回授到基極。其中 $R$ 代表電晶體的輸出電阻、負載電阻以及電感和電容上的等效電阻之總和。

若工作頻率不是很高，則可忽略電晶體內部的極間電容，因此我們可以獲得考畢子振盪器的振盪頻率為：

$$f_o = \frac{1}{2\pi \sqrt{L \left( \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2} \right)}} \quad (\text{Hz}) \quad (1-2)$$

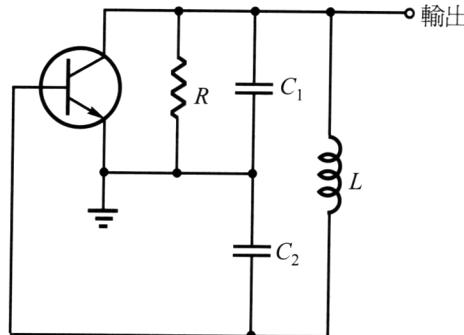


圖1-2 考畢子振盪器交流等效電路

接著我們考慮考畢子振盪器的振盪條件，考畢子振盪器的回授因數(Feedback Factor,  $\beta$ )為 $C_1 / C_2$ ，電晶體放大器的電壓增益(Voltage Gain,  $A$ )為 $g_m R$ ，由式1-1知振盪條件為：

$$A \beta(S) = 1$$

## ■ 1-4 通訊原理實習

所以

$$g_m R \frac{C_1}{C_2} = 1$$

因此

$$g_m R = \frac{C_2}{C_1}$$

當開始振盪時，迴路增益至少為 1，所以振盪條件為：

$$g_m R \geq \frac{C_2}{C_1} \quad (1-3)$$

圖 1-3 為考畢子振盪電路，其中  $R_1$ 、 $R_2$ 、 $R_3$  和  $R_4$  提供電晶體工作偏壓， $C_1$  為耦合電容， $C_2$  為旁路電容， $C_3$ 、 $C_4$  和  $L_1$  構成諧振電路，用來選取適當的工作頻率。

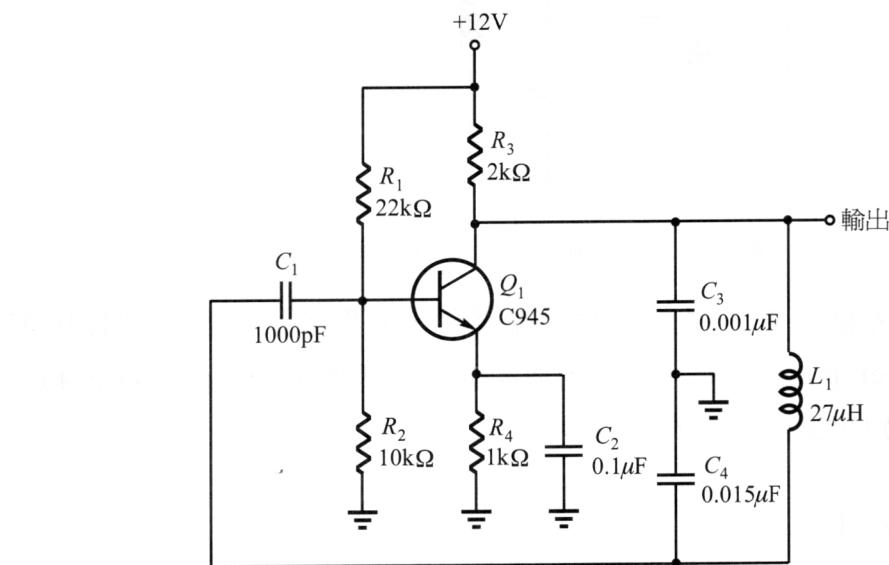


圖 1-3 考畢子振盪電路

## 二、哈特萊振盪器(Hartley Oscillator)

圖 1-4 為哈特萊振盪器交流等效電路，和考畢子振盪器一樣，其並聯的 LC 諧振電路連接在電晶體放大器的基極和集極上，所不同的是其部份電壓是由  $L_1$  和  $L_2$  所組成分壓器回授到基極，其中  $R$  亦代表電晶體的輸出電阻、負載電阻以及電感和電容上的等效電阻之總和。

當工作頻率不高時，可以忽略電晶體上的極間電容，因此振盪頻率可由並聯諧振電路所決定，其表示式如下

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{(L_1 + L_2)C}} \quad (\text{Hz}) \quad (1-4)$$

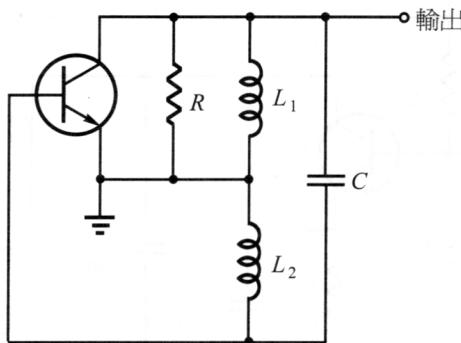


圖 1-4 哈特萊振盪器交流等效電路

哈特萊振盪器的回授因數  $\beta$  為  $L_2/L_1$ ，電晶體之放大增益  $A$  為  $g_m R$ ，因為振盪之條件為：

$$A \beta(S) = 1$$

所以

$$g_m R \frac{L_2}{L_1} = 1$$

## ■ 1-6 通訊原理實習

因此

$$g_m R = \frac{L_1}{L_2}$$

當開始振盪時，迴路增益須至少為 1，所以振盪條件為

$$g_m R \geq \frac{L_1}{L_2} \quad (1-5)$$

圖 1-5 為哈特來振盪電路，其中  $R_1$ 、 $R_2$  和  $R_3$  提供電晶體工作偏壓， $C_1$  為耦合電容， $C_2$  為旁路電容， $C_3$ 、 $L_1$  和  $L_2$  構成諧振電路，以選取適當的工作頻率。

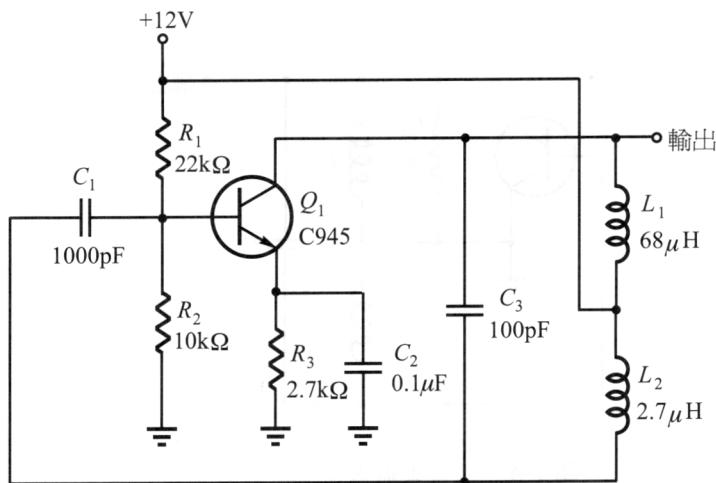


圖 1-5 哈特萊振盪電路

除了以上介紹的振盪器之外，還有許多其他形式的振盪器，例如使用在頻率較低的 RC 相移振盪器和偉恩電橋振盪器，以及頻率穩定度較高的克萊伯(Clapp)振盪器和皮爾士(Pierce)振盪器。通常在設計頻率較高的振盪器時會選擇皮爾士振盪器，因為其電路中以石英振盪晶體(Crystals)取代電感，而石英振盪晶體本身具有低的電路損耗和極高且穩定的  $Q$  值，所以適用於較高頻的電路中。

## 參、實驗項目

### 實驗一：考畢子振盪器

1. 如圖 1-3 之電路，將  $J1$  及  $J3$  短路， $J2$  及  $J4$  開路，即是  $C_3$  為  $0.001\mu F$ ， $C_4$  為  $0.015\mu F$ ， $L_1$  為  $27\mu H$ 。
2. 以示波器 AC 檔觀察輸出端(O/P)之信號，將輸出信號波形及頻率記錄於表 1-1 中。若無法振盪或失真太大，則檢查電晶體之直流偏壓是否適當。
3. 拆下  $J1$  及  $J3$  利用電容表和電感表測量實際值，記錄於表 1-1 中，並求出輸出頻率之理論值。
4. 將  $J2$  及  $J4$  短路， $J1$  及  $J3$  開路，即是將  $C_3$  改為  $C_5$ ， $C_4$  改為  $C_6$ ， $L_1$  改為  $L_2$ ，其值分別為  $100pF$ ， $1000pF$  和  $2.7\mu H$ ，重複步驟 2 和步驟 3。

### 實驗二：哈特萊振盪器

1. 如圖 1-5，將  $J1$  及  $J3$  短路， $J2$  及  $J4$  開路，即是  $L_1$  為  $68\mu H$ ， $L_2$  為  $2.7\mu H$ ， $C_3$  為  $100pF$ 。
2. 以示波器 AC 檔觀察輸出端(O/P)之信號，將輸出信號波及頻率記錄於表 1-2 中。若無法振盪或失真太大，則檢查電晶體之直流偏壓是否適當。
3. 拆下  $J1$  及  $J3$  利用電容表和電感表測量實際值，記錄於表 1-2 中，並求出輸出頻率之理論值。
4. 將  $J2$  及  $J4$  短路， $J1$  及  $J3$  開路，即是將  $L_1$  改為  $L_3$ ， $L_2$  改為  $L_4$ ， $C_3$  改為  $C_4$ ，其值分別為  $470\mu H$ ， $47\mu H$  和  $150pF$ ，重複步驟 2 和步驟 3。

## 肆、實驗結果

表 1-1 考畢子振盪器實驗結果

	$C_3$	$C_4$	$L_1$	輸出信號波形
標示值	0.001 $\mu\text{F}$	0.015 $\mu\text{F}$	27 $\mu\text{H}$	
測量值				理論值 $f_o =$ 測量值 $f_o =$
標示值	100pF	1000pF	2.7 $\mu\text{H}$	
測量值				理論值 $f_o =$ 測量值 $f_o =$

表 1-2 哈特萊振盪器實驗結果

	$L_1$	$L_2$	$C_3$	輸出信號波形
標示值	$68\mu\text{H}$	$2.7\mu\text{H}$	$100\text{pF}$	
測量值				理論值 $f_o =$ 測量值 $f_o =$
標示值	$470\mu\text{H}$	$47\mu\text{H}$	$150\text{pF}$	
測量值				理論值 $f_o =$ 測量值 $f_o =$

## 五、問題討論

- 在實驗一和實驗二中，輸出信號的理論值和測量值是否相同？若不相同原因為何？
- 圖 1-3 考畢子振盪器電路中，每個電容和電感的功能各為何？
- 試設計一個哈特萊振盪器如圖 1-5，其輸出頻率為 5MHz，則  $C_3$ 、 $L_1$  和  $L_2$  的值各為多少？
- 為何當頻率升高到射頻範圍時須特別注意佈線和縮短導線長度？